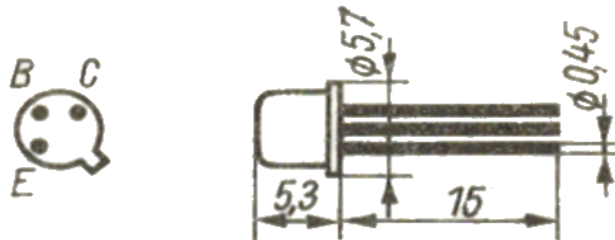


RFT SC116 – SC117 – SC118 - SC119

Silizium- pnp- Planar- Epitaxie- NF- Transistoren



Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SC116	SC117	SC118	SC119	
U_{CBO}	= 20	30	60	80	V
U_{CEO}	= 20	30	60	80	V
U_{EBO}	= 5	5	5	5	V
I_C	=	100			mA
I_B	=	50			mA
P_{tot}	=	300			mW
ϑ_j	=	+175			°C
ϑ_a	=	-40 ... +125			°C

Elektrische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$)

		SC116d	
F	(bei $U_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 0,2\text{mA}$)	typ. 2,5	dB
f_T	(bei $U_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 10\text{mA}$)	typ. 90	MHz

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985